

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号  
特開2002-208572  
(P2002-208572A)

(43)公開日 平成14年7月26日(2002.7.26)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テームト*(参考)
H 0 1 L 21/304	6 2 1	H 0 1 L 21/304	6 2 1 B 3 C 0 5 8
B 2 4 B 21/00		B 2 4 B 21/00	6 2 1 E A

審査請求 未請求 請求項の数7 O L (全 10 頁)

(21)出願番号 特願2001-1832(P2001-1832)

(22)出願日 平成13年1月9日(2001.1.9)

(71)出願人 000000239

株式会社荏原製作所

東京都大田区羽田旭町11番1号

(72)発明者 国沢 淳次

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社  
荏原製作所内

(72)発明者 木村 憲雄

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社  
荏原製作所内

(74)代理人 100091498

弁理士 渡邊 勇 (外3名)

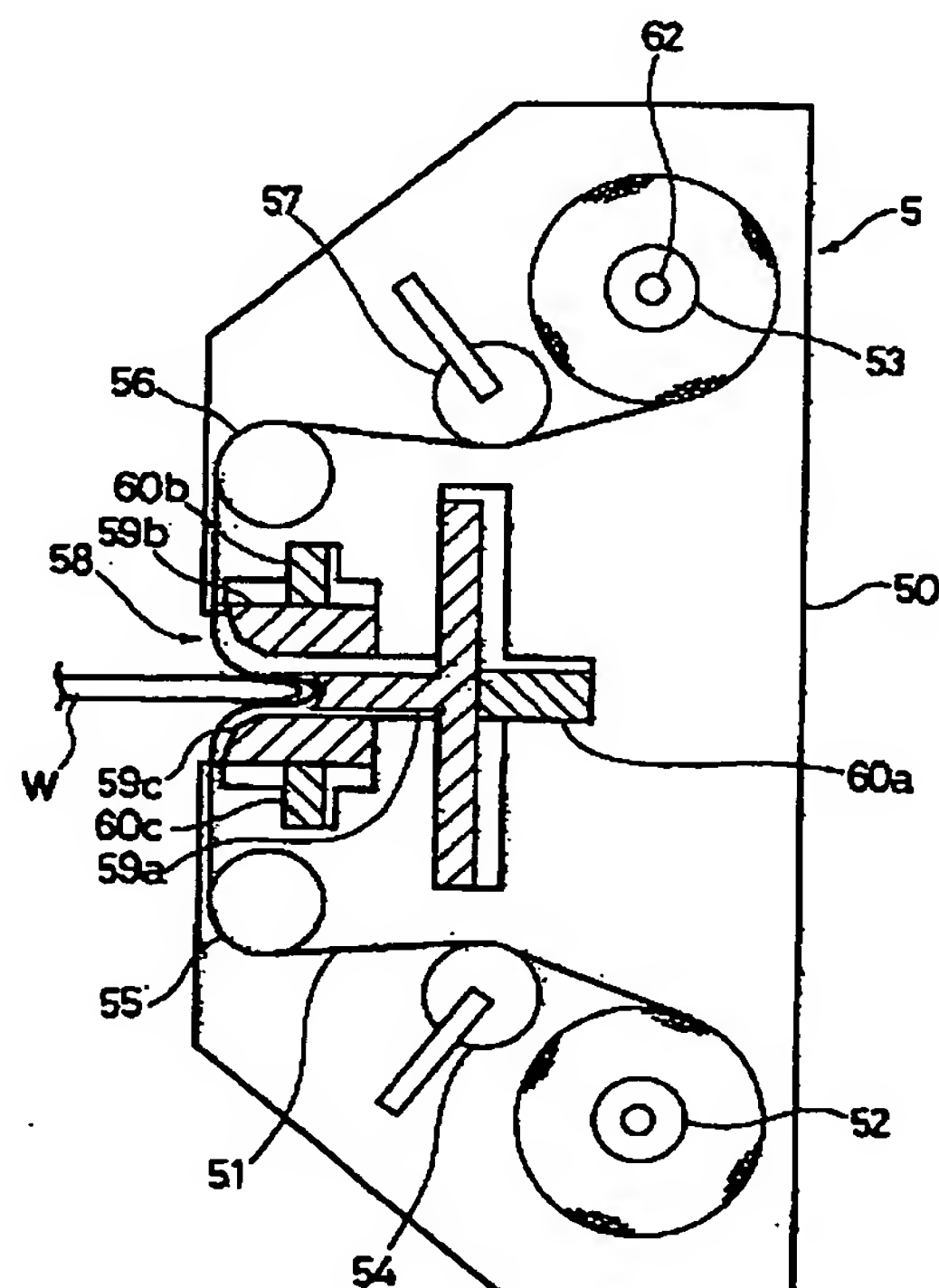
Fターム(参考) 3C058 AA05 AA07 AA09 AA12 AA14  
AB04 CB02 DA17

(54)【発明の名称】 研磨装置

(57)【要約】

【課題】 基板の周縁部及び裏面などにおける不要な膜や傷を研磨により効果的に除去することができるコンパクトな研磨装置を提供する。

【解決手段】 研磨面を有する研磨テープ51が巻回された供給リール52と、研磨テープ51を巻取る巻取リール53と、供給リール52と巻取リール53との間で研磨テープ51を基板Wの被研磨面に押圧する押圧部材59a, 59b, 59cと、巻取リール53を回転させるモータ61とを備えた。研磨カートリッジ5には、供給リール52と巻取リール53と押圧部材59a, 59b, 59cとが収納され、カートリッジ保持部6には、研磨カートリッジ5が着脱自在に保持される。





## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 研磨面を有する研磨テープが巻回された供給リールと、

前記研磨テープを巻取る巻取りリールと、

前記供給リールと前記巻取りリールとの間で前記研磨テープを研磨対象物の被研磨面に押圧する押圧部材と、

前記巻取りリールを回転させるモータとを備えたことを特徴とする研磨装置。

【請求項2】 前記供給リールと前記巻取りリールと前記押圧部材とを収納したカートリッジと、

前記カートリッジを着脱自在に保持するカートリッジ保持部とを備えたことを特徴とする請求項1に記載の研磨装置。

【請求項3】 前記押圧部材は、前記研磨テープを前記研磨対象物の側面に押圧することを特徴とする請求項1又は2に記載の研磨装置。

【請求項4】 前記押圧部材は、前記研磨テープを前記研磨対象物の裏面に押圧することを特徴とする請求項1又は2に記載の研磨装置。

【請求項5】 前記押圧部材は、前記研磨テープを前記研磨対象物の表面に押圧することを特徴とする請求項1又は2に記載の研磨装置。

【請求項6】 研磨後の前記研磨対象物の被研磨面を洗浄する洗浄装置と、  
前記洗浄装置により洗浄された前記研磨対象物を乾燥する乾燥装置とを備えたことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の研磨装置。

【請求項7】 研磨後の前記研磨対象物の被研磨面を検査する検査装置を備えたことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載の研磨装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、研磨装置、特に半導体ウェハなどの研磨対象物の表面を研磨する研磨装置に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】近年、半導体基板上に配線回路を形成するための金属材料として、アルミニウム又はアルミニウム合金に代えて、電気抵抗率が低くエレクトロマイグレーション耐性が高い銅(Cu)を用いる動きが顕著になっている。この種の銅配線は、基板の表面に設けた微細凹みの内部に銅を埋込むことによって一般に形成される。この銅配線を形成する方法としては、CVD、スパッタリング及びめっきといった手法があるが、いずれにしても、周縁部を含む基板の表面全面に銅を成膜するか、周縁部をシールして基板の表面に銅を成膜した後、化学機械研磨(CMP)により不要の銅を研磨により除去している。このような成膜方法では、周縁部のシールが不完全な場合があるため、基板の周縁部、即ちエッジ部分に銅が成膜されたり、また基板の裏面にも銅が付着

したりすることがある。

【0003】一方、銅は半導体製造工程においてシリコン酸化膜中に容易に拡散し、その絶縁性を劣化させる等の理由により、不要な銅は基板上から完全に除去することが要求されている。しかも、回路形成部以外の基板の周縁部(エッジ部分及びベベル部分)及び裏面に付着した銅は不要であるばかりでなく、その後の基板の搬送、保管・処理の工程において、クロスコンタミネーションの原因ともなり得るので、銅の成膜工程やCMP工程直後に完全に除去する必要がある。

【0004】また、例えば、基板の裏面やベベル部分における傷やパーティクルはCMP工程でのマイクロスクラッチの原因となることがあり、基板の裏面に付着したダストはキャリア内で下側の基板に落ちることにより成膜工程での欠陥の原因となることがある。このため、基板の周縁部及び裏面における傷やパーティクルを除去する必要性が増加している。

【0005】従来、上述した基板の周縁部及び裏面に付着した銅や傷を除去するために、基板上面の回路形成部に形成された銅膜表面に保護コーティングを施した基板を水平回転させながら、周縁部に銅エッチング液を供給して、基板の周縁部に付着した銅を溶解除去するようにしたものや、保護コーティングを施した基板を酸溶液に浸漬して該基板の周縁部に形成した金属膜をエッチング除去するようにしたもの、更には、基板表面に異物や金属不純物を取込んだシリコン酸化膜を形成し、このシリコン酸化膜をエッチング除去するようにしたもの等種々の方法が提案されている。

## 【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した従来のエッチングによる除去方法では、基板上に形成される膜の種類によってはエッチングレートが遅くなってしまう、所定の時間内にエッチングが終了しない場合がある。また、エッチングレートを上げるために温度を上げた場合には、耐薬品、耐高温性が必要とされるため装置の構成が複雑になる。

【0007】本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みてなされたもので、基板の周縁部及び裏面などにおける不要な膜や傷を効果的に除去することができるコンパクトな研磨装置を提供することを目的とする。

## 【0008】

【課題を解決するための手段】このような従来技術における問題点を解決するために、本発明の一態様は、研磨面を有する研磨テープが巻回された供給リールと、上記研磨テープを巻取る巻取りリールと、上記供給リールと上記巻取りリールとの間で上記研磨テープを研磨対象物の被研磨面に押圧する押圧部材と、上記巻取りリールを回転させるモータとを備えたことを特徴とする。

【0009】この場合において、上記押圧部材は、上記研磨テープを上記研磨対象物の側面に押圧することとし



てもよく、上記研磨対象物の裏面に押圧することとしてもよい。あるいは、上記押圧部材は、上記研磨テープを上記研磨対象物の表面に押圧することとしてもよい。

【0010】これにより、極めてコンパクトな構成により研磨対象物の周縁部及び裏面における不要な膜や傷を研磨により効果的に除去することができる。また、研磨対象物の周縁部や裏面だけでなく、基板の表面（回路形成面）を研磨する装置としても利用することが可能である。この場合には、従来のCMPに比べて極めてコンパクトな構成で基板の表面を研磨することができるので、装置全体のコンパクト化を図ることが可能となる。

【0011】また、本発明の好ましい一態様は、上記供給リールと上記巻取リールと上記押圧部材とを収納したカートリッジと、上記カートリッジを着脱自在に保持するカートリッジ保持部とを備えたことを特徴とする。これによりカートリッジを必要に応じて簡単に交換することができる。

【0012】また、本発明の好ましい一態様は、研磨後の上記研磨対象物の被研磨面を洗浄する洗浄装置と、上記洗浄装置により洗浄された上記研磨対象物を乾燥する乾燥装置とを備えたことを特徴とする。

【0013】更に、本発明の好ましい一態様は、研磨後の上記研磨対象物の被研磨面を検査する検査装置を備えたことを特徴とする。これにより研磨後の被研磨面の状況に対応した研磨が可能となる。

【0014】

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る研磨装置の第1の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は本実施形態における研磨装置の全体構成を示す図である。研磨装置は、図1に示すように、研磨対象物としての半導体ウェハを研磨するための研磨部1と、研磨部1で研磨された半導体ウェハを洗浄するための洗浄部2とから構成されている。

【0015】図1に示すように、研磨部1には1組の研磨ユニット3a、3bが対称に配置されており、これらの研磨ユニット3a、3bには、基板を研磨部1に搬入出するための基板受渡台10a、10bがそれぞれ設けられている。また、洗浄部2には、1組のロード／アンロードユニット20a、20bと、1組の第1洗浄ユニット21a、21bと、1組の第2洗浄ユニット22a、22bと、反転機23a、23bとがそれぞれ対称に配置されている。

【0016】また、洗浄部2の第1洗浄ユニット21a、21b間には第1搬送装置24が配置され、第2洗浄ユニット22a、22b間には第2搬送装置25が配置されている。研磨部1及び洗浄部2は、相互の汚染を防止するために隔壁で仕切られており、特に、研磨部1のダークな雰囲気や洗剤工程以降を行なう洗浄部2に拡散させないために、各空間の空調や圧力調整等がなされている。

【0017】上述した研磨ユニット3aと3b、基板受渡台10aと10b、ロード／アンロードユニット20aと20b、第1洗浄ユニット21aと21b、第2洗浄ユニット22aと22b、反転機23aと23bは、それぞれ同一の構成であり、例えば、並列運転による2つの研磨処理を独立して行なうことができる。以下では、基本的に研磨ユニット3a、基板受渡台10a、ロード／アンロードユニット20a、第1洗浄ユニット21a、第2洗浄ユニット22a、反転機23aに関して説明し、研磨ユニット3b、基板受渡台10b、ロード／アンロードユニット20b、第1洗浄ユニット21b、第2洗浄ユニット22b、反転機23bに関する説明は省略する。

【0018】図2は、研磨部1に配置された研磨ユニット3aの要部を示す縦断面図である。図2に示すように、研磨ユニット3aは、上面に研磨布11が貼付され研磨面が構成された研磨テーブル12と、研磨対象物である半導体ウェハ（基板）Wを真空吸着により保持し、これを研磨テーブル12に押圧して研磨するトップリング13と、研磨布11と基板Wの間に研磨液Qを供給する研磨液ノズル14とを備えている。

【0019】図3（a）及び図3（b）は、洗浄部2の第1洗浄ユニット21aの概略を示す図である。図3（a）及び図3（b）に示すように、第1洗浄ユニット21aは、いわゆるロール／ロールタイプの低速回転型洗浄ユニットであり、基板Wを保持するための複数の直立したローラ30と、スポンジ等からなるローラ型のスクラブ洗浄用の洗浄部材31とを備えている。

【0020】第1洗浄ユニット21aのローラ30は、図3（a）に示すように、外方及び内方に移動自在であり、基板Wを取り囲むように配置されている。ローラ30の頂部には把持溝32が形成されており、基板Wの周縁部がこの把持溝32に保持されることによって基板Wがローラ30に保持される。また、ローラ30は回転自在に構成されており、ローラ30が回転することによってローラ30に保持された基板Wが回転するようになっている。

【0021】第1洗浄ユニット21aの洗浄部材31は、図3（b）に示すように、基板Wの上下に上下動可能に配設されており、その上下動により基板Wに接触可能となっている。また、第1洗浄ユニット21aには、基板Wの裏面にエッチング液を供給する薬液ノズル33a及び純水を供給する純水ノズル33bと、基板Wの上面にエッチング液を供給する薬液ノズル33c及び純水を供給する純水ノズル33dが配設されている。また第1洗浄ユニット21aには、図3（a）に示すように、研磨ユニット3aにおける研磨後の基板Wの周縁部を研磨するテープ研磨装置4が設けられているが、このテープ研磨装置4の詳細については後述する。

【0022】図4（a）及び図4（b）は、洗浄部2の



第2洗浄ユニット22aを示す概略図である。第2洗浄ユニット22aには、図4(b)に示すように、基板Wを把持するアーム40を回転軸の上端に放射状に取付けた回転テーブル41が配置されており、高速回転型の洗浄ユニットとなっている。この回転テーブル41は基板Wを1500～5000rpm程度の高速で回転させることができる。

【0023】また、第2洗浄ユニット22aには、図4(a)に示すように、ノズル42を備えた揺動アーム43が設置されており、このノズル42から超音波で加振された洗浄液が基板Wの上面に供給される。このように第2洗浄ユニット22aはいわゆるメガソニックタイプの高速回転型洗浄ユニットとなっている。

【0024】なお、第2洗浄ユニット22aには、プロセス性能向上やタクトタイム短縮のために、不活性ガスを供給するガスノズル44及び加熱によって乾燥を促進する加熱手段(図示せず)が設けられている。

【0025】次に、第1洗浄ユニット21aに設けられたテープ研磨装置について詳細に説明する。図5は本実施形態におけるテープ研磨装置4を示す平面図、図6はテープ研磨装置4の研磨カートリッジを示す縦断面図である。

【0026】テープ研磨装置4は、第1洗浄ユニット21a内に設けられており、基板Wの半径方向に移動可能とされている。テープ研磨装置4は、概略台形状のケース50内に薄厚の研磨テープ51を収納した研磨カートリッジ5と、この研磨カートリッジ5を着脱自在に保持するカートリッジ保持部6とから主として構成されている。このように研磨カートリッジ5はカートリッジ保持部6に対して脱着自在に装填できるので、研磨カートリッジ5を必要に応じて交換することができる。

【0027】研磨カートリッジ5のケース50に収容される研磨テープ51としては、例えば、ウレタンやポリエステルなどからなる基材フィルム上に、酸化アルミニウム、シリコンカーバイド、酸化クロム、ダイヤモンドなどの研磨砥粒を塗布して研磨面を構成したものが用いられ、例えば、3M社製インペリアルラッピングフィルムの#2000～#20000が好適である。また、研磨テープ51の幅が5～20mmであるものが好ましい。

【0028】図6に示すように、研磨カートリッジ5のケース50内には、上記研磨テープ51が巻回された供給リール52、供給リール52に巻回された研磨テープ51を巻取る巻取リール53、及び4つのローラ54～57が収容されている。供給リール52に巻回された研磨テープ51は、ローラ54、55、56、57を経由して巻取リール53に接続されている。

【0029】また、研磨カートリッジ5の側面には、基板Wの周縁部が挿入される凹部58が形成されており、この凹部58からはローラ55と56との間の研磨テ

ープ51が露出している。凹部58には、研磨テープ51を基板Wの側面に押圧する押圧部材59a、基板Wの周縁部上面に押圧する押圧部材59b、及び基板Wの周縁部裏面に押圧する押圧部材59cがそれぞれの圧縮バネ60a、60b、60cによって付勢された状態で配置されている。なお、これらの圧縮バネに代えて他の弾性体やエアアクチュエータを用いてもよい。

【0030】図5に示すように、カートリッジ保持部6にはモータ61が設けられており、このモータ61のシャフト62は、研磨カートリッジ5がカートリッジ保持部6に保持されたときに研磨カートリッジ5の巻取リール53に係合するようになっている。従って、カートリッジ保持部6のモータ61の駆動によって研磨カートリッジ5の巻取リール53が回転すると、供給リール52に巻回された研磨テープ51が巻取リール53に巻取られる。

【0031】テープ研磨装置4が基板Wの中心方向に移動することによって、基板Wの周縁部が研磨テープ51と共に凹部58に挿入される。そして、この挿入された基板Wが押圧部材59a、59b、59cをそれぞれ押付け、これによって研磨テープ51は基板Wの側面、周縁部上面、周縁部下面のそれぞれに押圧される。例えば、基板Wの側面及び基板Wの周縁部から数mm内側までの上下面に研磨テープ51を押圧する。このような状態でカートリッジ保持部6のモータ61を駆動させると、研磨カートリッジ5の巻取リール53が回転し、押圧部材59a、59b、59cによって押圧された研磨テープ51が基板Wの側面、周縁部上面、周縁部下面にそれぞれ摺接しながら巻取リール53に巻取られ、研磨テープ51の研磨砥粒によって基板Wの側面、周縁上面、周縁下面が研磨される。

【0032】次に、このような構成の研磨装置を用いて半導体ウェハなどの基板を研磨する工程について説明する。成膜処理された基板を収容した基板カセットがロード／アンロードユニット20a上に載置されると、第2搬送装置25が基板カセットから基板Wを取り出し、この基板Wを反転機23aに渡す。反転機23aによって反転された基板Wは第1搬送装置24によって研磨部1の基板受渡台10aに載置される。

【0033】基板受渡台10a上の基板Wは、研磨ユニット3aのトップリング13によって保持され、研磨テーブル12上に移動される。そして、研磨液ノズル14から所定の研磨液Q(Si基板上の絶縁膜(酸化膜)を研磨する場合には所定の粒径の砥粒をアルカリ水溶液に浮遊させたもの)を供給する。この状態で研磨テーブル12とトップリング13とをそれぞれ回転させながら、トップリング13に保持された基板Wを研磨布11に押圧して、化学的・機械的研磨による基板Wの研磨が行なわれる。このようにして化学的・機械的に研磨された基板Wは、基板受渡台10aに移動され、第1搬送装置2



4により第1洗浄ユニット21aに搬送される。

【0034】第1洗浄ユニット21aでは、ローラ30により基板Wを保持すると共に、基板Wを数十〜300rpm程度の低回転数で回転させる。そして、研磨カートリッジ5が装填されたテープ研磨装置4を基板Wの中心側に移動させ、研磨カートリッジ5の凹部58に基板Wの周縁部を挿入する。この状態でカートリッジ保持部6のモータ61を駆動することによって、上述したように基板Wの側面、周縁部上面、周縁部下面が研磨される。なお、この研磨中には、テープ研磨装置4の近傍に配置されたノズル34から純水又は薬液を基板Wの周縁部に供給する。

【0035】基板Wの側面及び周縁部の研磨が終了すると、テープ研磨装置4を外方に待避させる。そして、上下のローラスポンジ（洗浄部材）31をそれぞれ下方及び上方に移動させて基板Wの上下面に接触させる。この状態で、上下に設置した純水ノズル33b, 33dから純水を供給することによって、基板Wの上下面を全面に亘ってスクラブ洗浄する。なお、この1次洗浄中に上記テープ研磨装置4によって基板Wの側面及び周縁部を研磨することとしてもよい。

【0036】スクラブ洗浄後、ローラスポンジ31をそれぞれ上方及び下方に待避させ、薬液ノズル33a, 33cからエッチング液を基板Wの上下面に供給し、基板Wの上下面のエッチング（化学的洗浄）を行って基板Wの上下面に残留する金属イオンを除去する。なお、このとき必要に応じて基板Wの回転速度を変化させる。その後、純水ノズル33b, 33dから純水を基板Wの上下面に供給し、所定時間の純水置換を行って上記エッチング液を除去する。このときも必要に応じて基板Wの回転速度を変化させる。

【0037】第1洗浄ユニット21aにおいて研磨及びスクラブ洗浄がなされた基板Wは、第1搬送装置24によって反転機23aに渡され、反転機23aによって反転される。反転機23aによって反転された基板は第2搬送装置25によって第2洗浄ユニット22aに搬送される。

【0038】第2洗浄ユニット22aでは、回転テーブル41により基板Wを保持すると共に、基板Wを100〜500rpm程度の低速で回転させる。そして、揺動アーム43を基板Wの全面に亘って揺動させながら、揺動アーム43の先端のノズル42から超音波で加振された純水を供給し、パーティクルの除去を行なう。パーティクルの除去が完了した後、純水の供給を止め、揺動アーム43を待機位置に移動させる。そして、基板Wを1500〜5000rpm程度で高速回転させ、ガスノズル44から必要に応じて清浄な不活性ガスを供給しながら基板Wのスピン乾燥を行なう。なお、このような超音波が印加された洗浄液を基板Wに供給して非接触的に洗浄を行なう方法に代えて又は追加して、ペンシル型の

（スポンジ等の）洗浄部材を基板Wに接触、走査させて洗浄を行なうこととしてもよい。

【0039】第2洗浄ユニット22aにおいて洗浄及び乾燥された基板Wは、第2搬送装置25によってロード／アンロードユニット20a上の基板カセットに戻される。

【0040】このように、本発明のテープ研磨装置を用いれば、極めてコンパクトな構成により基板の周縁部及び裏面における不要な膜や傷を効果的に除去することが可能となる。特に、本発明においては、硬い研磨面を用いるのではなく、変形可能な薄膜の研磨テープに基板のエッジ部分を押付けて研磨するため、研磨テープが基板の形状に沿って変形するので、基板の側面、周縁部上面、及び周縁部下面を同時に研磨することができる。

【0041】次に、本発明に係る研磨装置の第2の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、上述の第1の実施形態における部材又は要素と同一の作用又は機能を有する部材又は要素には同一の符号を付し、特に説明しない部分については第1の実施形態と同様である。

【0042】図7は本実施形態における第1洗浄ユニット21aの構成を概略的に示す平面図、図8は本実施形態におけるテープ研磨装置の研磨カートリッジを示す横断面図である。図7に示すように、本実施形態の第1洗浄ユニット21aには2つのテープ研磨装置7が設けられている。このテープ研磨装置7においては、図8に示すような横置きタイプの研磨カートリッジ8が用いられる。

【0043】この研磨カートリッジ8は、ローラ54〜57に加えて、更に2つのローラ70, 71を備えている。また、研磨カートリッジ8の凹部58には、研磨テープ51を基板の側面に押圧する押圧部材73が、圧縮バネ72によって付勢された状態で配置されており、この押圧部材73及び研磨テープ51は研磨カートリッジ8の側面から基板W側に突出している。また、テープ研磨装置7の研磨カートリッジ8は、第1の実施形態と同様に、カートリッジ保持部（図示せず）に対して脱着自在とされている。

【0044】基板Wの側面を研磨する場合には、上記研磨カートリッジ8の側面から突出した押圧部材73及び研磨テープ51を基板Wの側面に接触させ、この状態でカートリッジ保持部のモータを駆動させる。これにより、研磨カートリッジ8の巻取リール53が回転し、押圧部材73によって押圧された研磨テープ51が基板の側面に摺接しながら巻取リール53に巻取られ、研磨テープ51の研磨砥粒によって基板Wの側面が研磨される。

【0045】本実施形態においては、図7に示すように、基板Wの側面の膜厚を測定する膜厚センサ9が上記テープ研磨装置7に隣接して設けられている。この膜厚



センサ9により基板Wの側面の研磨中に該基板Wの側面の膜厚が測定され、この測定結果に応じてテープ研磨装置7による研磨時間を調整することができる。

【0046】これまで本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されず、その技術的思想の範囲内において種々異なる形態にて実施されてよいことは言うまでもない。

【0047】例えば、本実施形態におけるテープ研磨装置7を、図9に示すように、押圧部材73の突出部を上方に向けて基板Wの下方に配置し、このテープ研磨装置7を水平方向に移動可能としてもよい。このようにすれば基板Wの下面を全面に亘って研磨することができる。またこれとは逆に、上記テープ研磨装置を押圧部材の突出部を下方に向けて基板Wの上方に配置することとすれば、本発明に係るテープ研磨装置を基板の上面を研磨する研磨装置として利用することができる。

【0048】このように、本発明に係るテープ研磨装置によれば、基板Wの上面又は下面のいずれであっても研磨を行なうことができ、基板Wの回路形成面をも研磨することが可能となる。基板Wの回路形成面を研磨する研磨装置としてはCMPがあるが、CMPにおいては基板よりも大きな研磨布が必要とされるため、装置全体の寸法が大きくなる。一方、本発明に係るテープ研磨装置を用いれば、極めてコンパクトな構成により基板の表面を研磨することが可能となる。

【0049】また、上述の実施形態における第1洗浄ユニット21aでは、基板Wを保持するためにローラ30を用いたが、上述のようにテープ研磨装置を基板Wの下方に配置して基板Wの下面を研磨する場合には、図10に示すような真空チャック80によって基板Wに与える荷重の反力を受けることとしてもよい。即ち、真空ポンプ等の真空源Vacに接続される真空チャック80によって基板Wの上面を真空吸着して基板Wを保持し、この真空チャック80の下方にテープ研磨装置7を配置してもよい。この場合において、図11に示すように、複数のテープ研磨装置7a、7bを配置することとしてもよい。例えば、テープ研磨装置7aにおいて上述の3M社製のインペリアルラッピングフィルムの#20000の研磨テープを仕上げ研磨用として用い、テープ研磨装置7bにおいて#4000の研磨テープを初期研磨用として用いるなど、研磨テープの種類を変えて使用することも可能である。また、例えば、初期研磨用のテープ研磨装置7bによって一次研磨した後に、仕上げ研磨用のテープ研磨装置7aによって仕上げ研磨できるように、初期研磨用テープ研磨装置7bの移動に従って仕上げ研磨用テープ研磨装置7aを移動させることも可能である。更に、基板Wの下面の膜厚を測定する膜厚センサ9を設置して、測定結果に応じてテープ研磨装置7a、7bによる研磨時間を調整することとしてもよい。

【0050】図10及び図11に示すような真空チャッ

ク80を用いて基板Wを保持すると、例えば、回路形成面が上面であったときに、基板Wの回路形成面が真空チャック80に接触して汚染される場合が考えられる。そこで、図12及び図13に示すように、周縁部に環状の真空シール81を備えた真空チャック82を用いて基板Wを保持するのが好ましい。この真空シール81は、天然ゴム、合成ゴム又は軟質プラスチックのような弾性を有する部材から形成され、真空シール81の内径は保持する基板Wの外径よりも少し小さくなっている。真空シール81には下方に開口する逆V字状の溝83が形成され、この溝83は排気経路84を介して真空ポンプ等の真空源Vacに接続されている。この溝83の内部空間を負圧にすることによって基板Wがその周縁部において保持される。このような真空チャック82では、真空チャック82と接触する部分は基板Wの周縁部だけなので、基板Wの上面が汚染されることがない。

【0051】また、研磨装置の各ユニットの構成及びユニットの台数は、上述したものに限られるものではない。例えば、図14に示すように、上記テープ研磨装置を備えた研磨ユニット90、研磨ユニット90における研磨後の基板を洗浄する洗浄ユニット91、洗浄ユニット91において洗浄された基板を乾燥する乾燥ユニット92を装置内に配置し、更に、研磨ユニット90における研磨後の基板の被研磨面を検査する検査ユニット93を装置内に配置することとしてもよい。あるいは、図15に示すように、テープ研磨装置を備えた研磨ユニット90、検査ユニット93、洗浄・乾燥ユニット94を装置内に配置することも可能である。検査ユニット93は、例えば、CCDカメラと、その出力を画像処理するコンピュータとを有するものや渦電流式センサ又は光学式で膜厚を測定する機能を有するもの等が適宜用いられる。この検査ユニット93では所定の研磨処理がなされたかどうかを合否判定し、判定結果に対応した処理を行なう。例えば、不合格であった場合に基板をロード/アンロードユニット20a又は20bに戻す前に再度研磨を行い、あるいは、次の基板に研磨条件を変化させてフィードバックさせるなどの処理を行なうことが考えられる。このような検査ユニット93を設置すれば、研磨後の基板の被研磨面の状況に対応した研磨が可能となる。

【0052】

【発明の効果】上述したように、本発明によれば、極めてコンパクトな構成により研磨対象物の周縁部及び裏面における不要な膜や傷を研磨により効果的に除去することができる。また、研磨対象物の周縁部や裏面だけでなく、回路形成面である基板の表面を研磨する装置としても利用することが可能である。この場合には、従来のCMPに比べて極めてコンパクトな構成で基板の表面を研磨するので、装置全体のコンパクト化を図ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】



【図1】本発明の第1の実施形態における研磨装置の全体構成を示す平面図である。

【図2】図1の研磨部に配置された研磨ユニットの要部を示す縦断面図である。

【図3】図1の洗浄部の第1洗浄ユニットの概略を示す図である。

【図4】図1の洗浄部の第2洗浄ユニットの概略を示す図である。

【図5】本発明の第1の実施形態におけるテープ研磨装置を示す平面図である。

【図6】図5のテープ研磨装置のカートリッジを示す縦断面図である。

【図7】本発明の第2の実施形態における第1洗浄ユニットの構成を概略的に示す平面図である。

【図8】本発明の第2の実施形態におけるテープ研磨装置のカートリッジを示す横断面図である。

【図9】本発明の他の実施形態におけるテープ研磨装置を示す縦断面図である。

【図10】本発明の他の実施形態におけるテープ研磨装置を示す縦断面図である。

【図11】本発明の他の実施形態におけるテープ研磨装置を示す縦断面図である。

【図12】本発明の他の実施形態における基板を保持する機構を示す縦断面図である。

【図13】図12に示す真空シールの部分拡大図である。

【図14】本発明の他の実施形態における研磨装置の全体構成を示す平面図である。

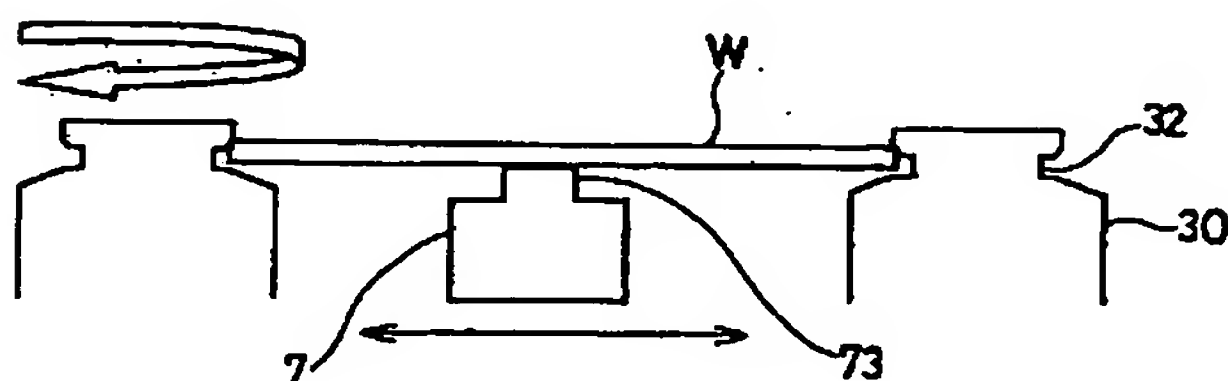
【図15】本発明の他の実施形態における研磨装置の全体構成を示す平面図である。

【符号の説明】

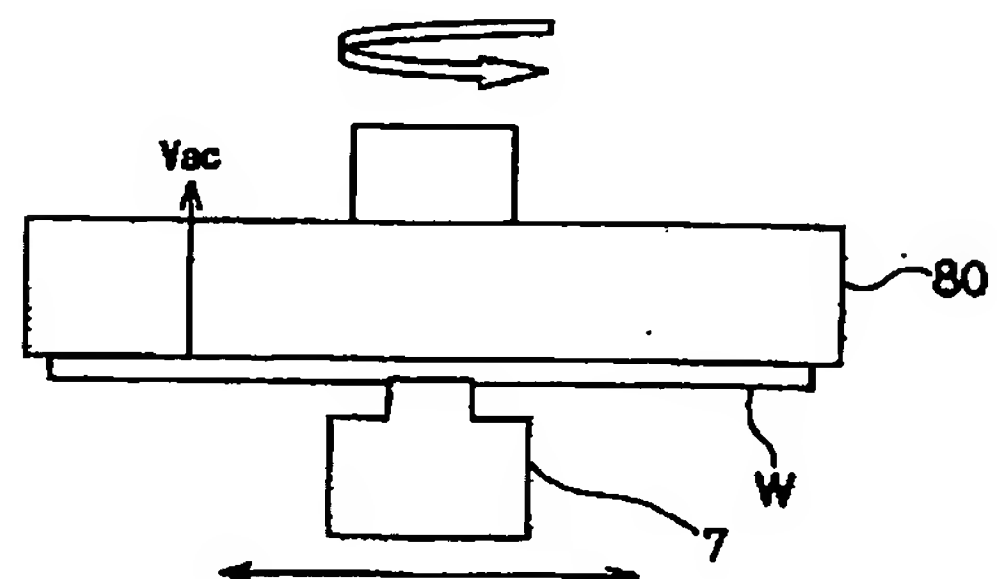
- 1 研磨部
- 2 洗浄部
- 3 a, 3 b, 90 研磨ユニット
- 4, 7 テープ研磨装置
- 5, 8 研磨カートリッジ
- 6 カートリッジ保持部
- 9 膜厚センサ

- 10 a, 10 b 基板受渡台
- 11 研磨布
- 12 研磨テーブル
- 13 トップリング
- 14 研磨液ノズル
- 20 a, 20 b ロード/アンロードユニット
- 21 a, 21 b 第1洗浄ユニット
- 22 a, 22 b 第2洗浄ユニット
- 23 a, 23 b 反転機
- 24 第1搬送装置
- 25 第2搬送装置
- 30 ローラ
- 31 洗浄部材
- 32 把持溝
- 33 a, 33 c 薬液ノズル
- 33 b, 33 d 純水ノズル
- 34, 42 ノズル
- 40 アーム
- 41 回転テーブル
- 43 揺動アーム
- 44 ガスノズル
- 50 ケース
- 51 研磨テープ
- 52 供給リール
- 53 巻取リール
- 54~57, 71, 72 ローラ
- 58 凹部
- 59 a, 59 b, 59 c, 73 押圧部材
- 60 a, 60 b, 60 c, 72 圧縮バネ
- 61 モータ
- 62 シャフト
- 80, 82 真空チャック
- 81 真空シール
- 83 溝
- 84 排気経路
- 91 洗浄ユニット
- 92 乾燥ユニット
- 93 検査ユニット

【図9】

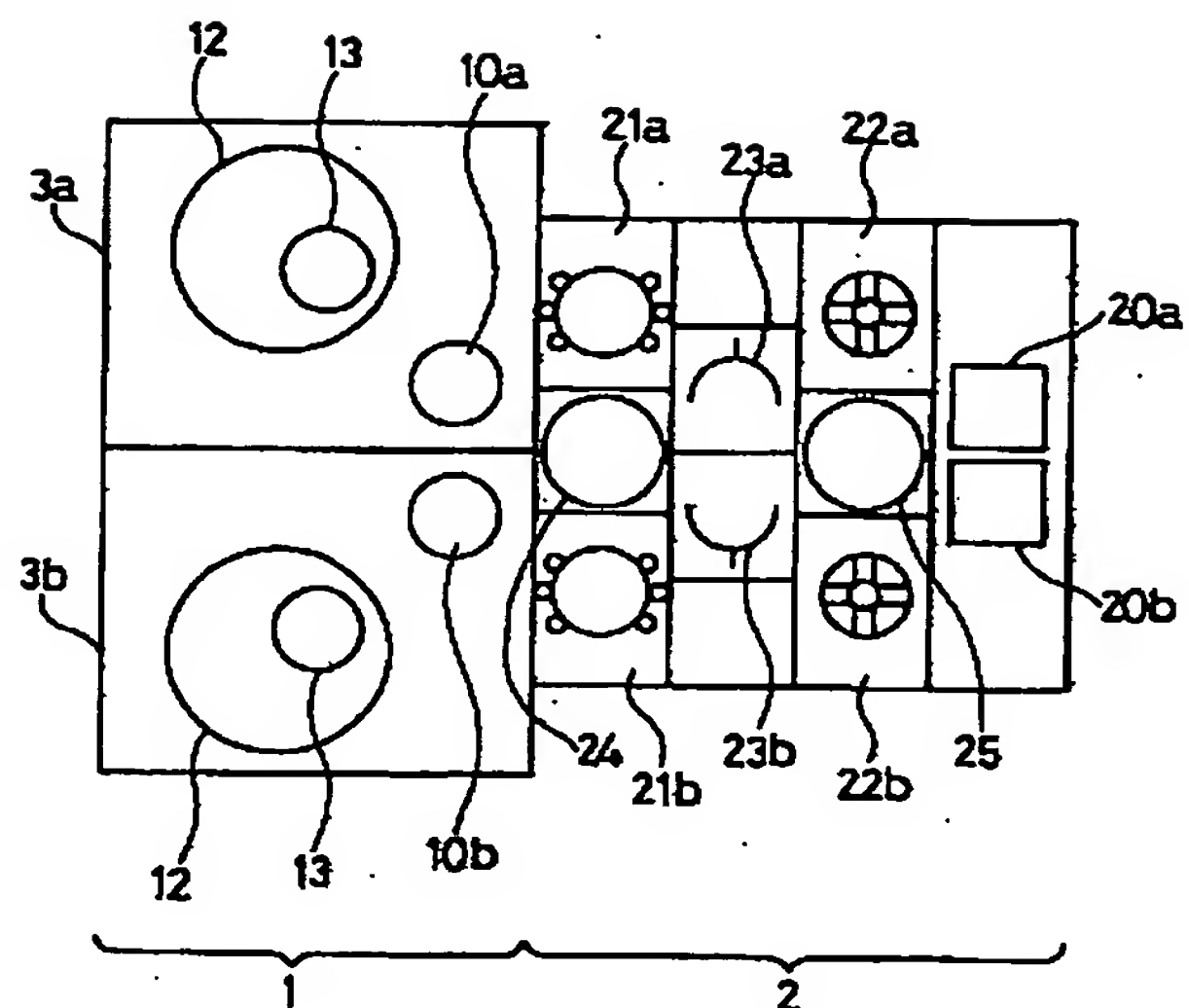


【図10】

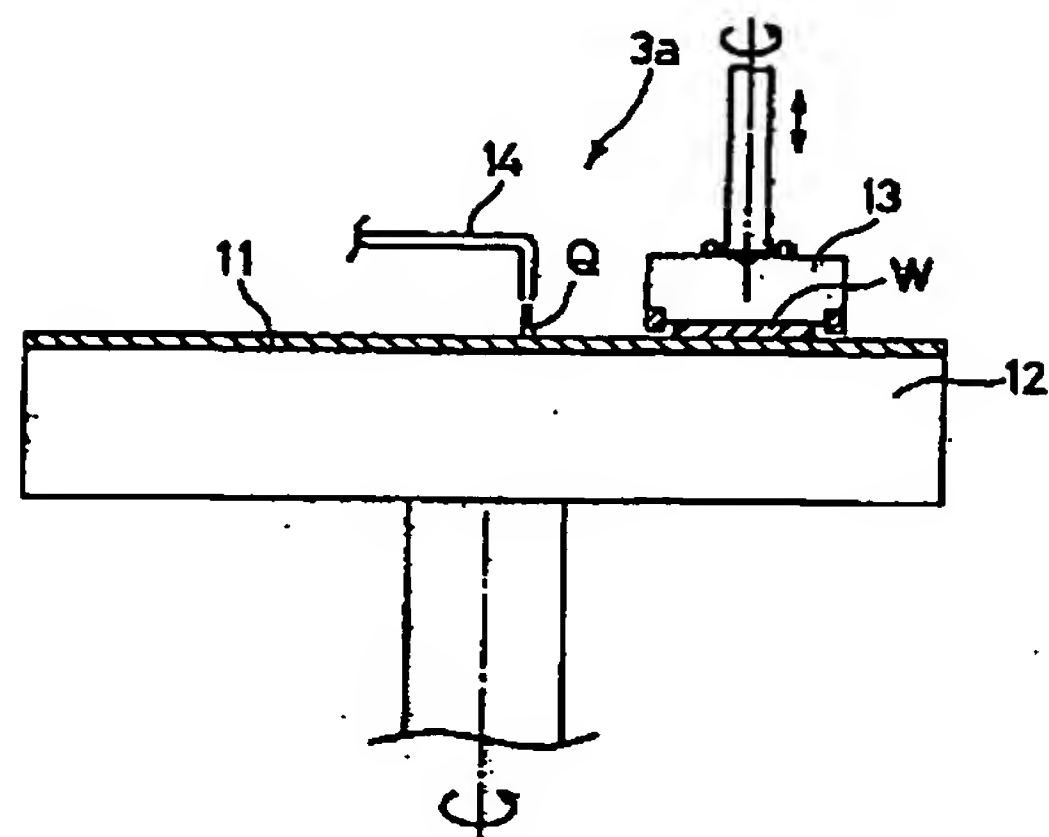




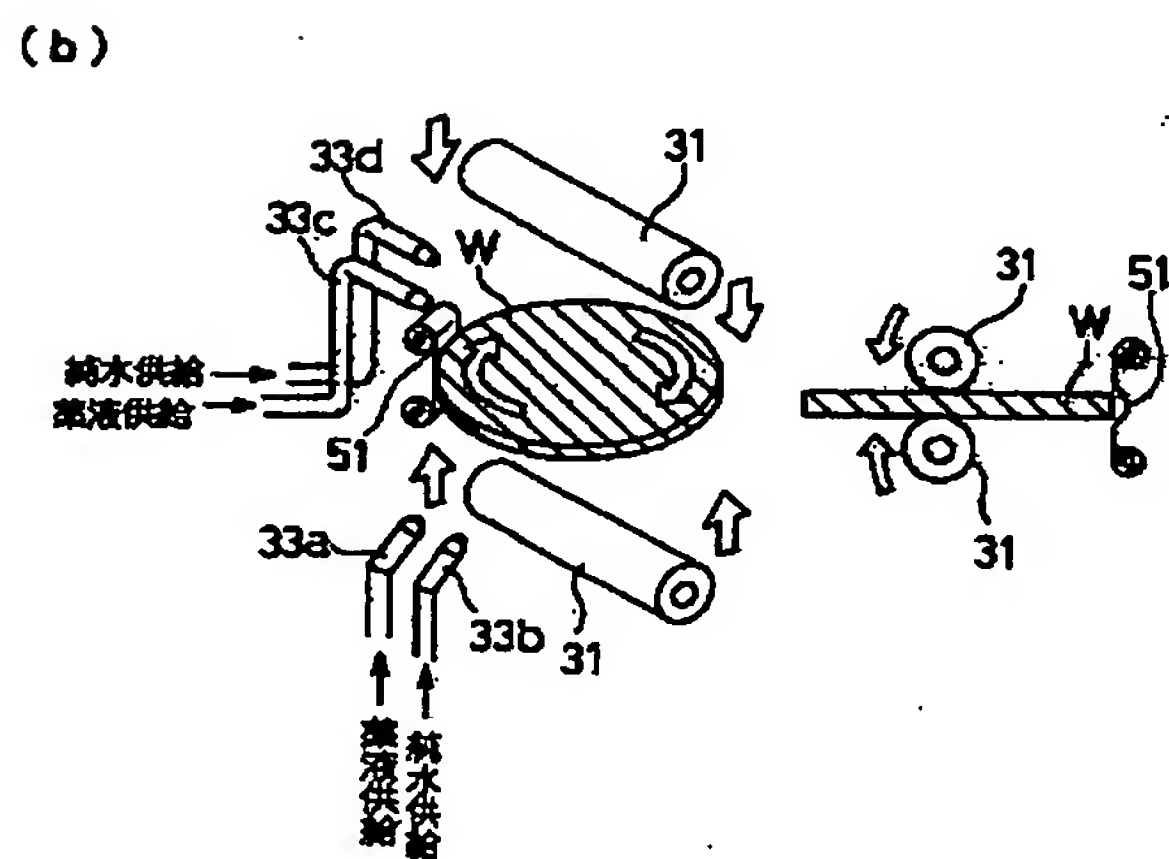
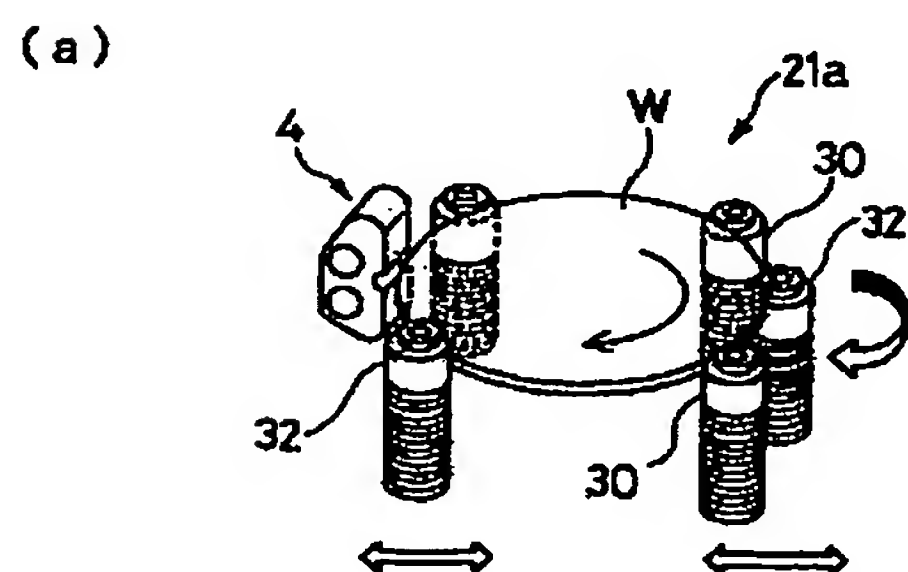
【図 1】



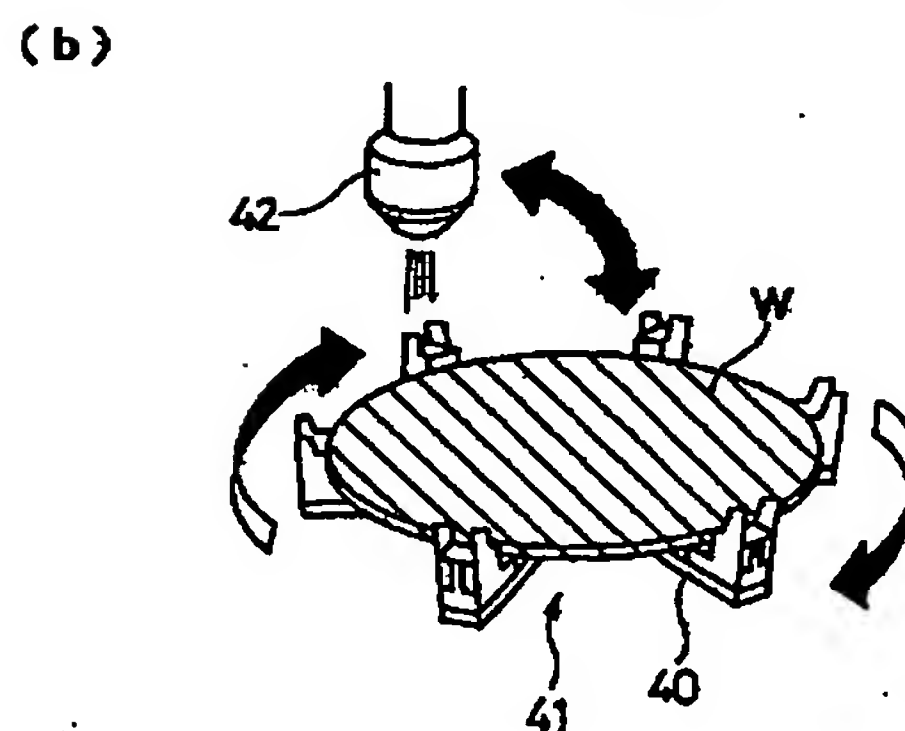
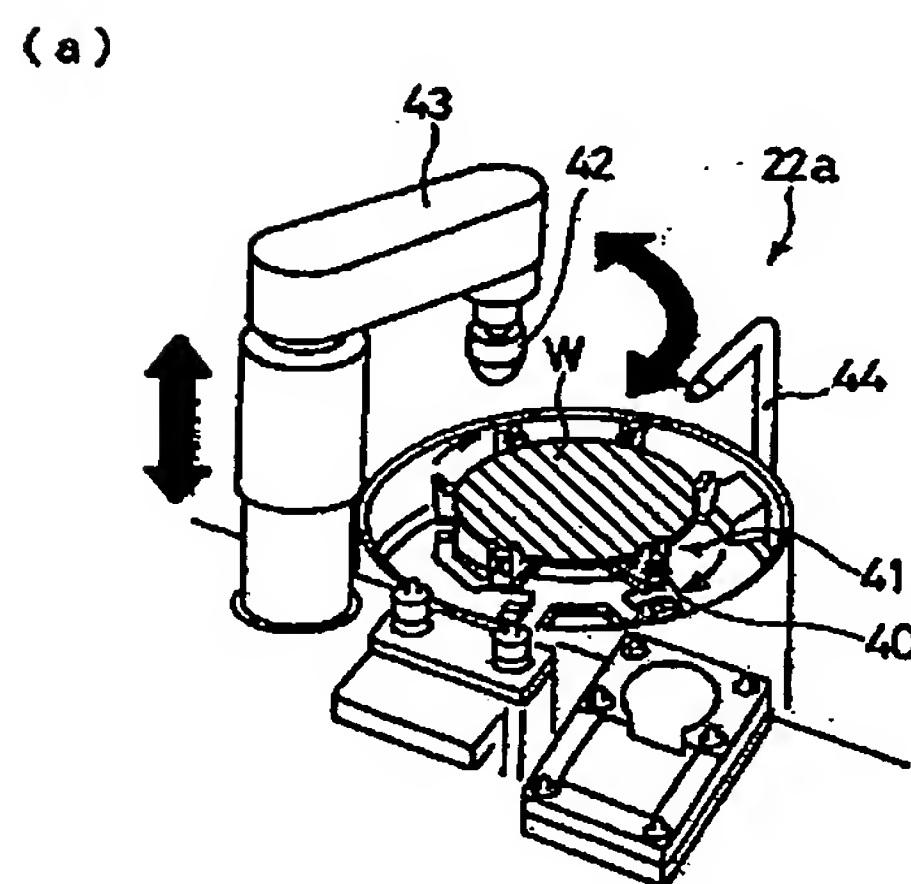
【図2】



【図3】

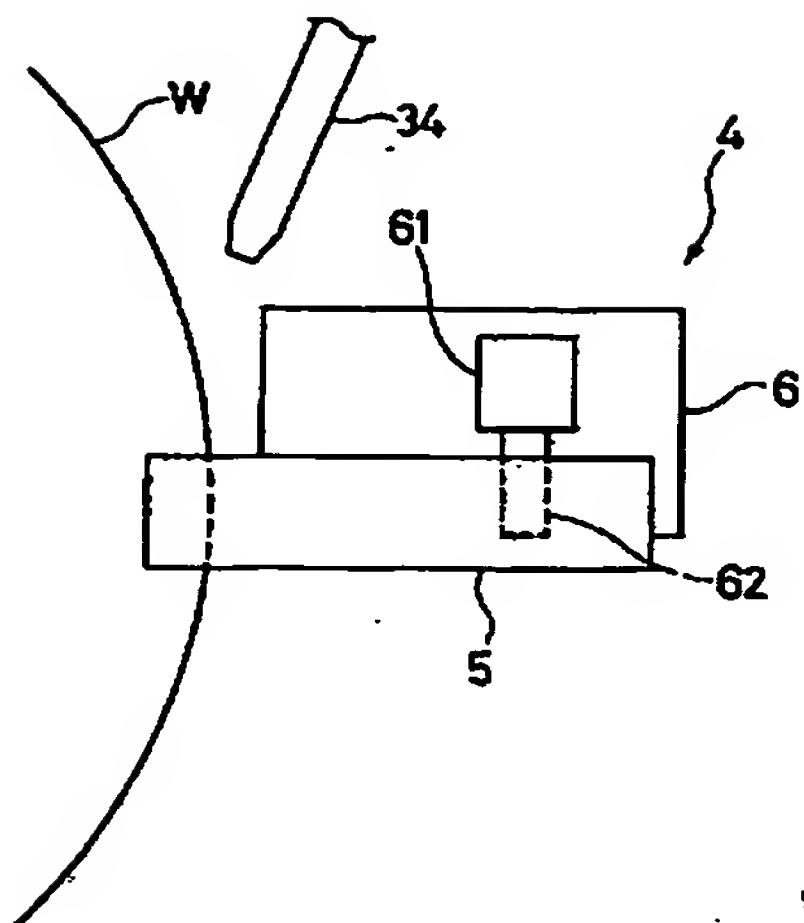


【例4】

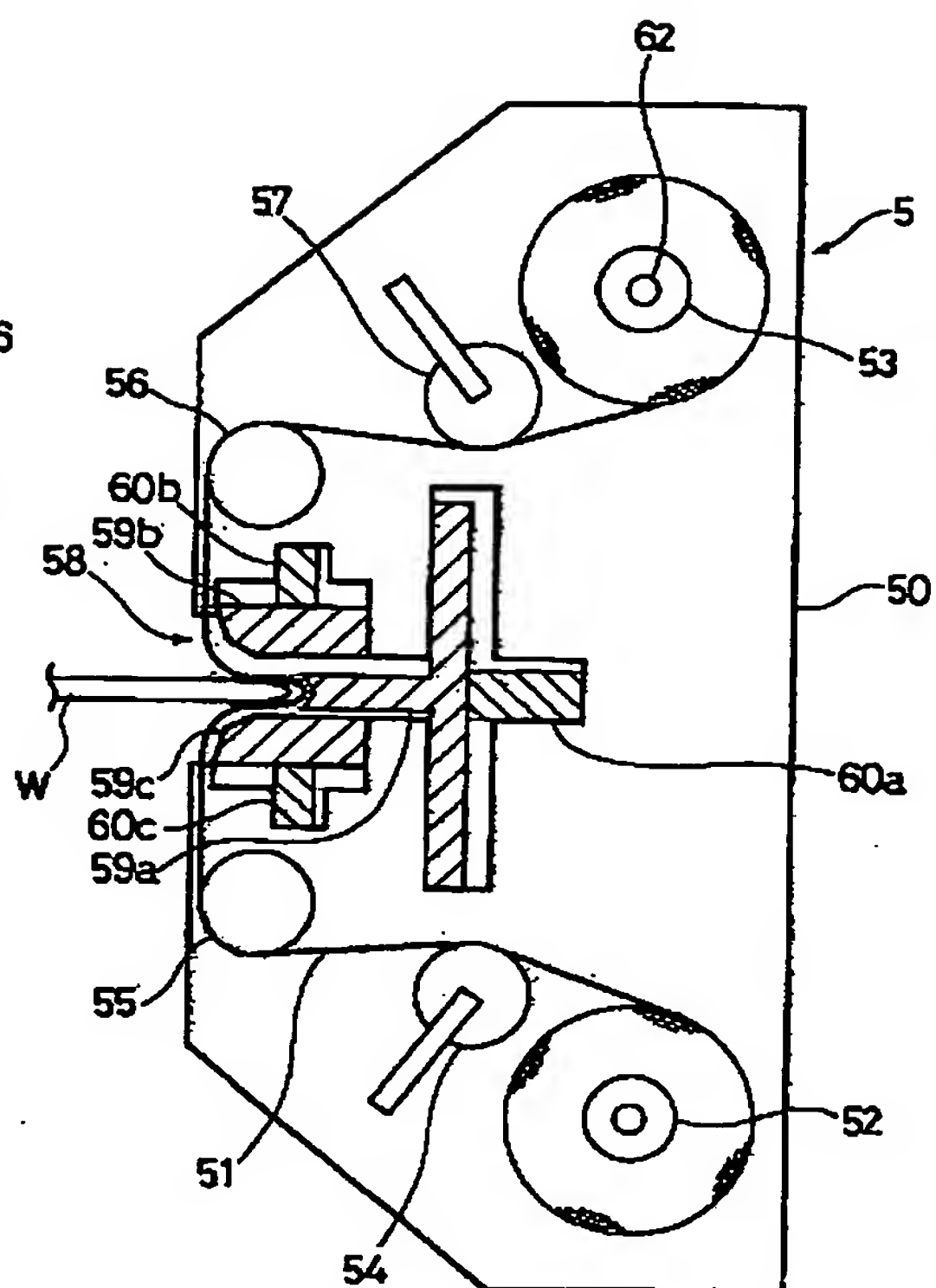




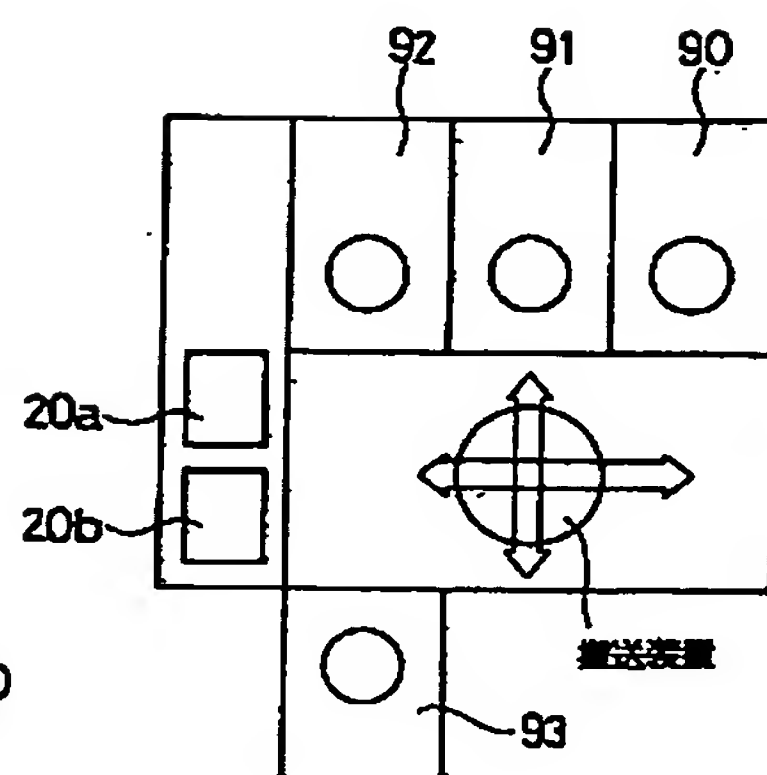
【図5】



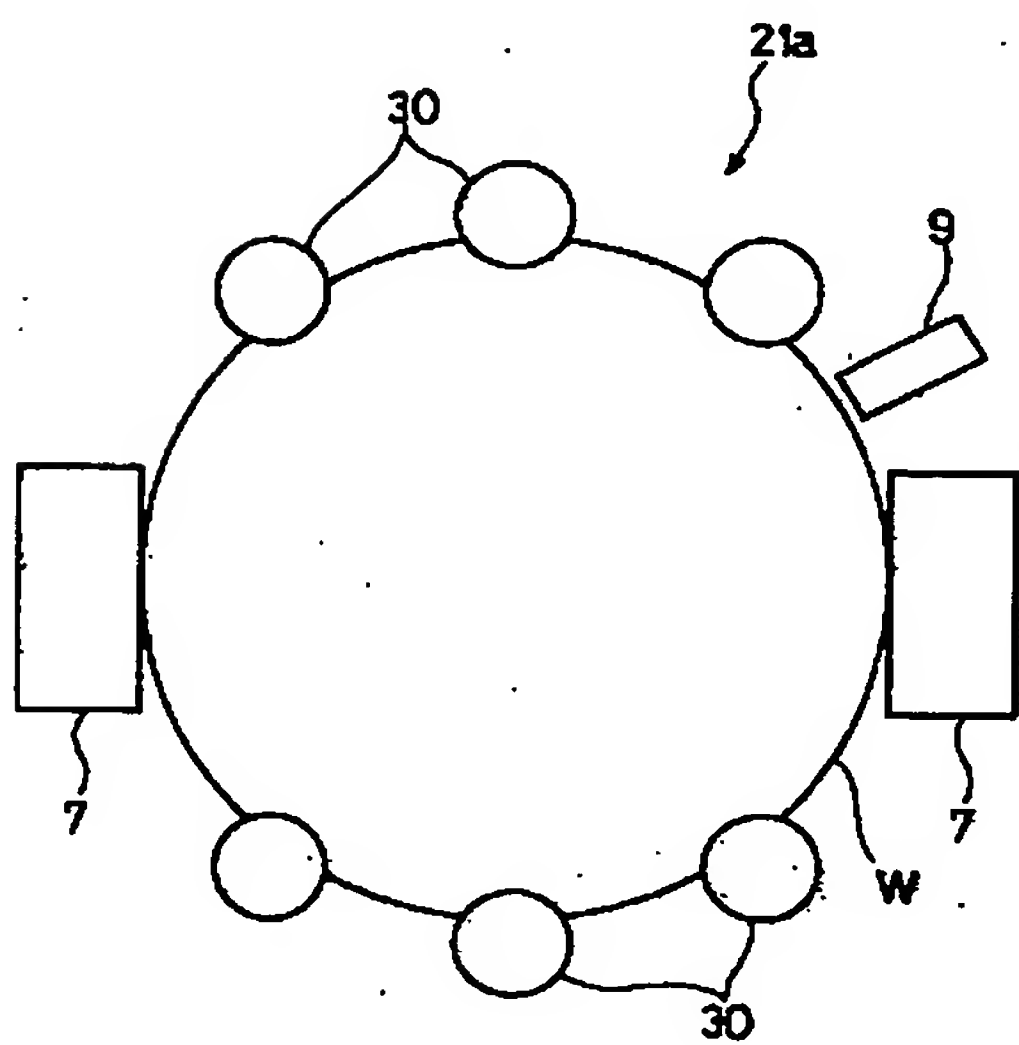
【図6】



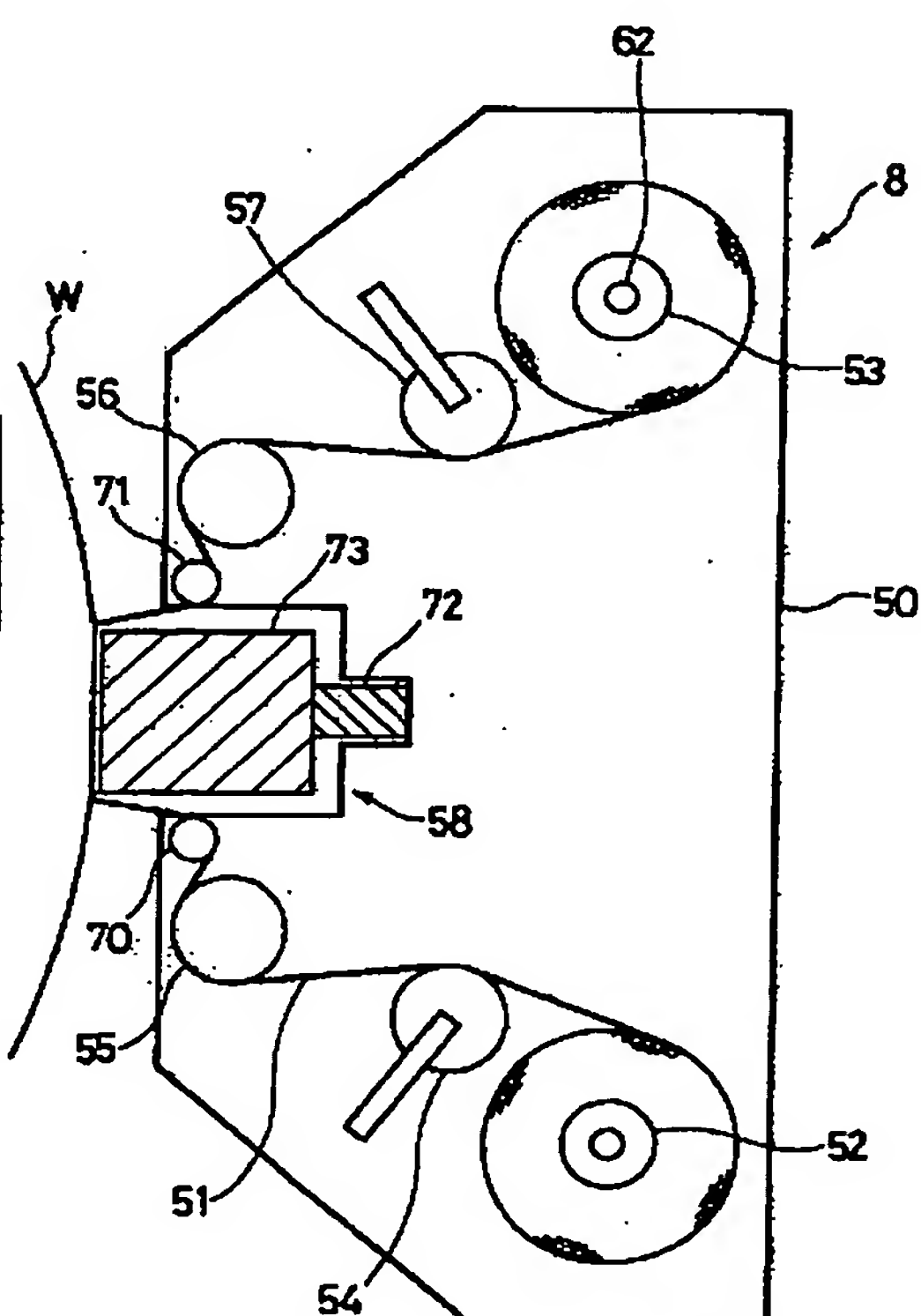
【図14】



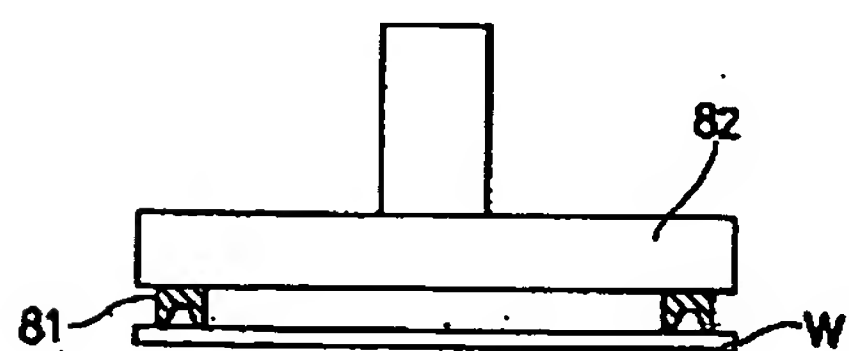
【図7】



【図8】

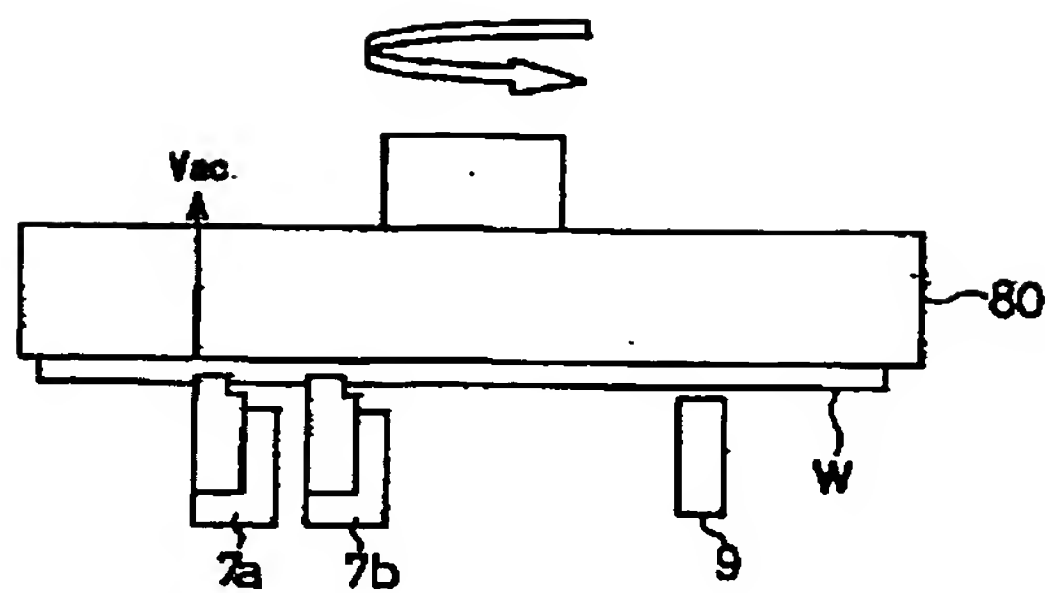


【図12】

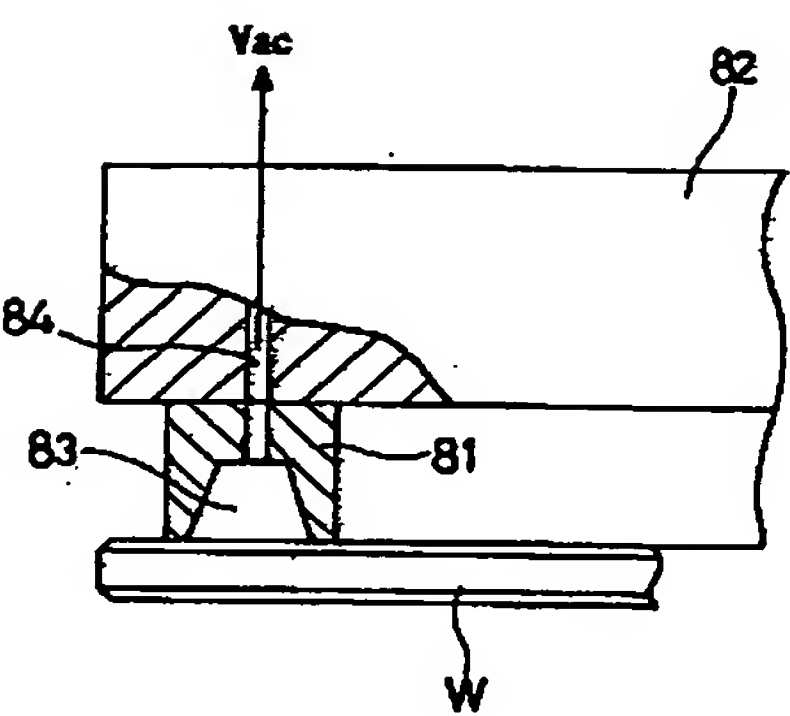




【図11】



【図13】



【図15】

